

СВЕДЕНИЯ ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ОППОНЕНТЕ

по диссертации Поволоцкого Алексея Валерьевича «Процессы, обусловленные лазерно-индуцированным возбуждением электронов и их миграцией в системах с дискретным и зонным энергетическим спектром», представленной на соискание ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 01.04.21 – лазерная физика.

Цэндин Константин Дамдинович

Доктор физико-математических наук.

Специальность 01.04.10 – физика полупроводников.

Главный научный сотрудник.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук

194021, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 26

Web: <http://www.ioffe.ru>

E-mail: post@mail.ioffe.ru

Тел: (812) 297-22-45

Основные публикации по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях:

1. Bogoslovskiy N., Tsendin K. Dynamics of the current filament formation and its steady-state characteristics in chalcogenide based PCM. *Solid-State Electronics*. – 2017. – V. 129. – P. 10.
2. Bogoslovskiy N.A., Petrov P.V., Ivánov Y.L., Averkiev N.S., Tsendin K.D. Effect of coulomb correlations on luminescence and absorption in compensated semiconductors. *Semiconductors*. – 2016. – V. 50. – P. 888.
3. Bogoslovskiy N., Tsendin K. Role of the changing sign of effective electron-electron correlation energy for information recording in PCM. *Physica Status Solidi (B) Basic Research*. – 2015. – V. 252. – P. 1339.
4. Korobova N., Almasov N., Prikhodko O., Timoshenkov S., Tsendin K. Efficient method of structural and electronic properties modification of amorphous As-S-Se chalcogenide films. *Materials Science and Technology Conference and Exhibition 2014*. – 2014. – V. 2. – P. 753.
5. Fefelov S.A., Kazakova L.P., Kozyukhin S.A., Tsendin K.D., Arsova D., Pamukchieva V. Current-voltage characteristics of thin Ge₂Sb₂Te₅ films taken using a measuring circuit with a current source. *Technical Physics*. – 2014. – V. 59. – P. 546.
6. Prkhodko O., Almasov N., Dyussebayev S., Maksimova S., Ushanov V., Tsendin K., Nesterov S. Bismuth impurity influence on electronic properties of amorphous As₄₀Se₃₀S₃₀ films. *Chalcogenide Letters*. – 2013. – V. 10. – P. 519.